

Projet 8 - ISOL_MOS / Commande isolée pour transistor MOSFET

Projet : LMP1
Info : [DATA098]
Révision : 2 du 10 mars 1999 – Orcad 4.20
Révision : 3 du 6 octobre 2001 – Orcad 9.xx
Révision : 5 du 16 janvier 2002 – Orcad 9.xx

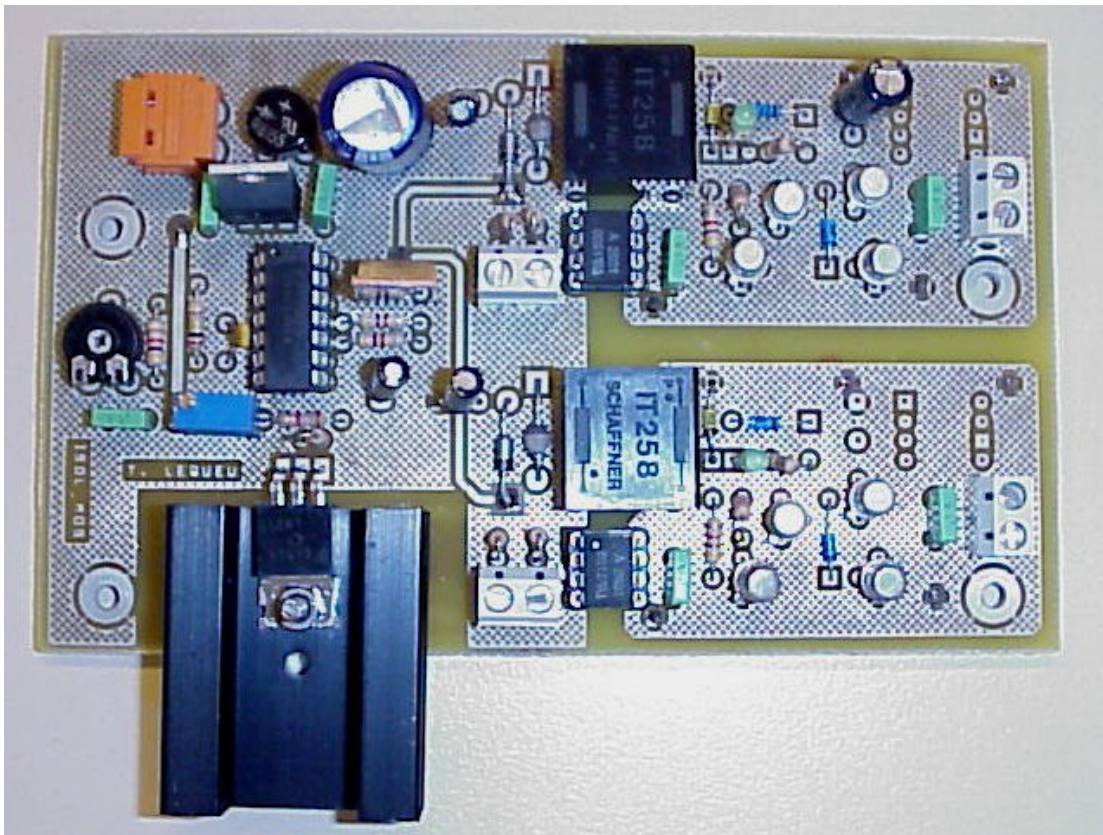


Fig. 8.1. Commande isolée pour MOSFET (images-maquettes\isol-mos-51.jpg).

8.1 Liste des plans

- Calcul du régulateur LM 217.
- Liste des composants.
- Allure des principaux composants.
- Schéma électronique.
- Circuit imprimé.
- Documentations des composants.

8.2 Calcul du régulateur LM 217

La figure 8.2 donne le schéma de montage des régulateurs ajustables LM 117/217/317.

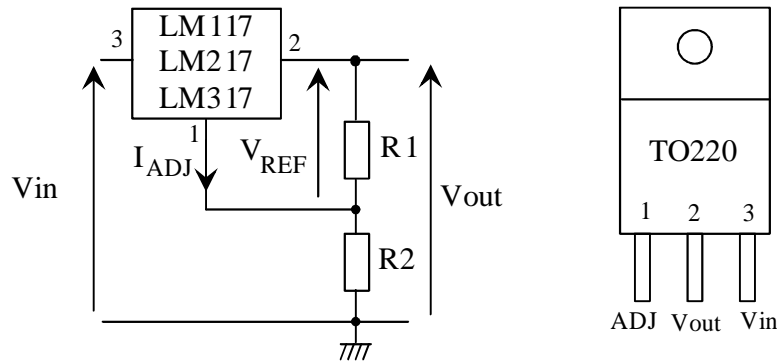


Fig. 8.2. Schéma de montage du régulateur (orcad\lmp1\regul1.drw).

La valeur de V_{REF} est constante et vaut $V_{REF} = 1,25 \text{ V}$. Le courant de polarisation du régulateur I_{ADJ} est donné à $I_{ADJ} = 50 \mu\text{A}$. On prendra une chute de tension minimal $V_{IN} - V_{OUT}$ de 3V.

Les courant dans R1 et R2 sont donnés par :

$$I_1 = \frac{V_{REF}}{R1} \text{ et } I_2 = I_1 + I_{ADJ} = \frac{V_{REF}}{R1} + I_{ADJ} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{R2} \quad (8.1)$$

On en déduit alors l'expression de la tension de sortie V_{OUT} :

$$V_{OUT} = R2 \cdot (I_1 + I_{ADJ}) + V_{REF} = \left(\frac{R2}{R1} + 1 \right) \cdot V_{REF} + R2 \cdot I_{ADJ} \quad (8.2)$$

On peut également exprimer la valeur de la résistance R2 en fonction de V_{OUT} :

$$R2 = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{(I_1 + I_{ADJ})} = \frac{V_{OUT} - V_{REF}}{\left(\frac{V_{REF}}{R1} + I_{ADJ} \right)} \quad (8.3)$$

Dans les notes d'applications, on trouve deux valeurs de résistances R1 :

$$R1 = 120 \Omega \text{ et } R1 = 240 \Omega$$

Le tableau donne la plage de variation de la résistance R2, pour $R1 = 240 \Omega$ en fonction de la tension de sortie désirée V_{OUT} , ainsi que la valeur du condensateur de filtrage.

Tableau 8.1. Calcul des régulateurs LM 117/217/317 (orcad\lmp1\regulateurs.xls).

Vout (en V)	5	9	12	15	18	20	24
R2 (en ohms)	713	1474	2044	2615	3185	3566	4326
Vin mini (en V)	8	12	15	18	21	23	27
V2AC eff (en V)	9	12	15	18	22	24	24
Vc maxi (en V)	12,0	16,3	20,5	24,8	30,4	33,2	33,2
Iout maxi (en A)	1	1	1	1	1	1	1
C mini (en uF)	2483	2342	1814	1480	1062	976	1602

8.3 Liste des composants

Tableau 8.2. Liste de composants (projets-lmp1.xls / ISOL_MOS).

No	Quantité	Référence	Désignation	Empreinte
1	4	C1,C9,C10,C12	100nF	CK06
2	2	C11,C2	1uF	RADIAL08
3	1	C3	120uF	RADIAL08
4	2	C13,C14,C4	4.7uF	RADIAL06
5	1	C5	680pF	CK06
6	1	C6	330uF	RADIAL08
7	1	C7	330nF	CK06
8	1	C8	10uF	RADIAL06
10	7	D1,D3,D6,D7,D10,D11,D12,D13	BAT46	DO35
11	2	D14,D2	BYV95A	DO41
12	2	D17,D4	5.1V	DO35
13	2	D16,D5	Verte	LED5
14	1	D8	1A 100V	REDROND
15	2	D15,D9	24V	DO41
17	2	JP5,JP1	SORTIE	02PL2
18	2	JP4,JP2	ENTREE	02PL2
19	1	JP3	ALIM	WEID2
20	6	Q1,Q2,Q4,Q6,Q7,Q9	2N2222A	TO18
21	2	Q8,Q3	2N2907A	TO18
22	1	Q5	IRF520N	TO220
23	2	R17,R1	2.2K	RC04
24	2	R16,R2	4.7K	RC04
25	2	R22,R3	750	RB71
26	1	R4	100K	RC04
27	1	R5	10K	RC04
28	2	R6,R10	470	RC04
29	1	R7	47k	RAJ1
30	2	R20,R8	470	RB71
31	2	R19,R9	1K	RB71
32	2	R18,R11	R_ON	RC04
33	2	R21,R12	R_OFF	RC04
34	1	R13	2K	RAJ10TV
35	1	R14	1.8K	RC04
36	1	R15	240	RB71
37	2	T2,T1	IT258	TI3-03
38	1	U1	CD4093	14DIP300L
39	1	U2	LM317	TO220
40	1	U3	7815	TO220
41	2	U5,U4	HCPL2601	08DIP300L
42	4	VIS1,VIS2,VIS3,VIS4	VISSERIE	M3L

8.4 Allure des principaux composants

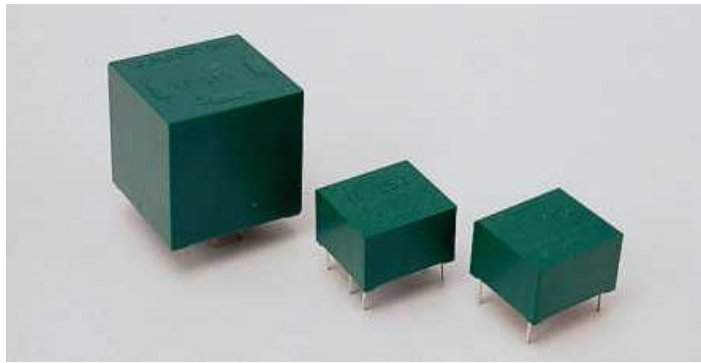


Fig. 8.3. Transformateurs d'impulsions (images-composants\ti1.jpg).

Type de boîtier:

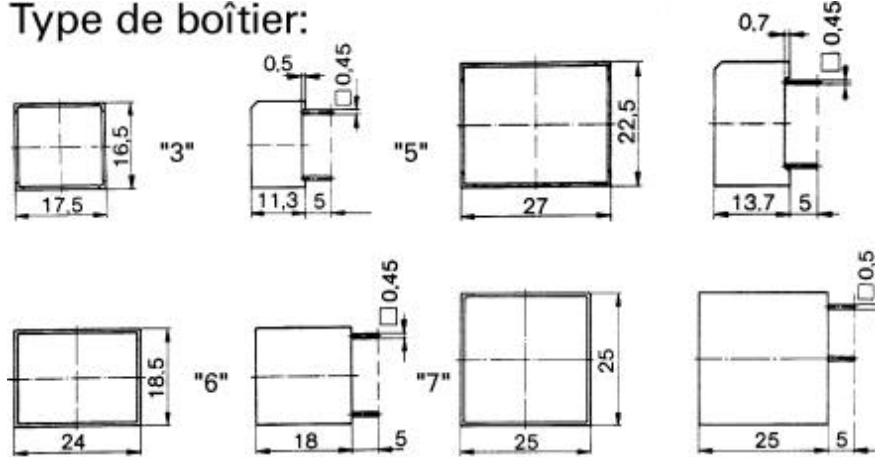


Fig. 8.4. Transformateurs d'impulsions (images-composants\ti2.gif).

Connexions

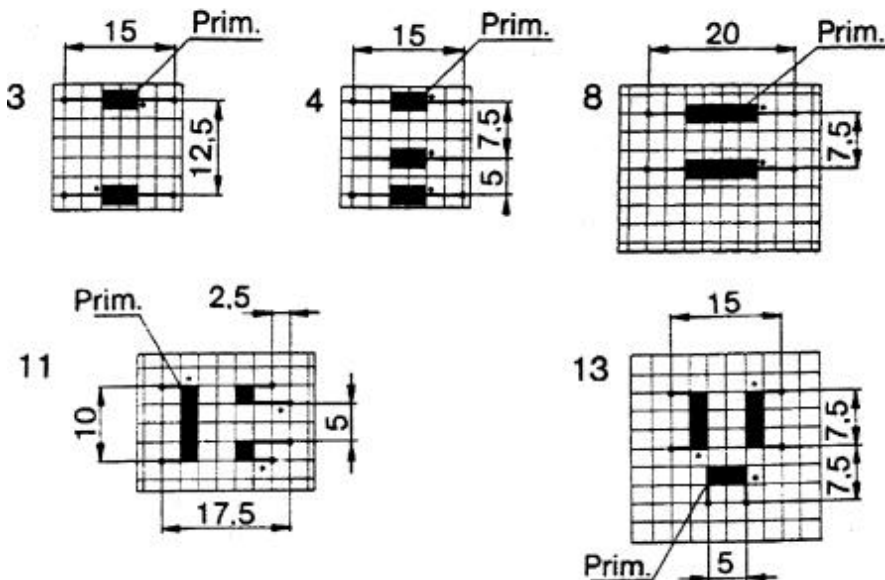


Fig. 8.5. Transformateurs d'impulsions (images-composants\ti3.gif).

8.5 Circuit imprimé de la version 2 du 16 mars 1999

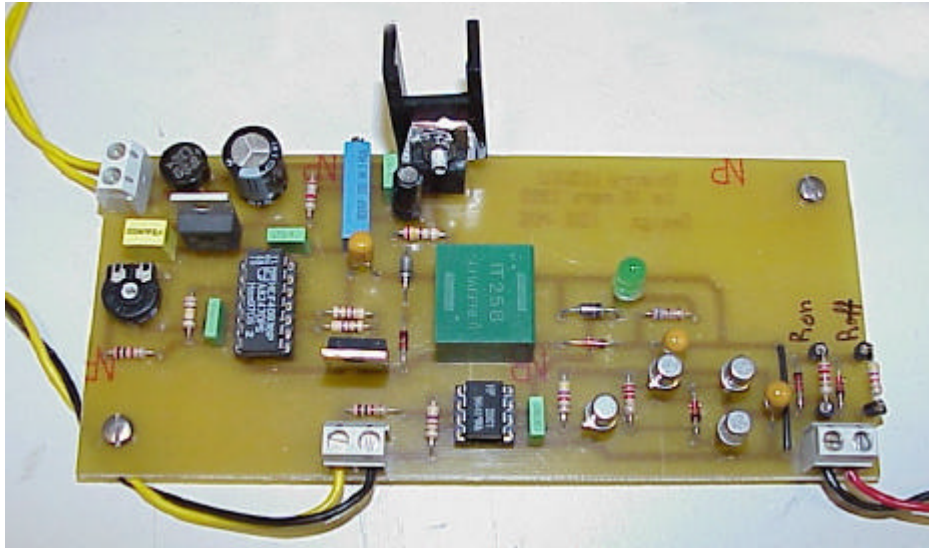


Fig. 8.6. Commande isolée pour MOSFET (images-maquettes\cde-mosfet1.jpg).

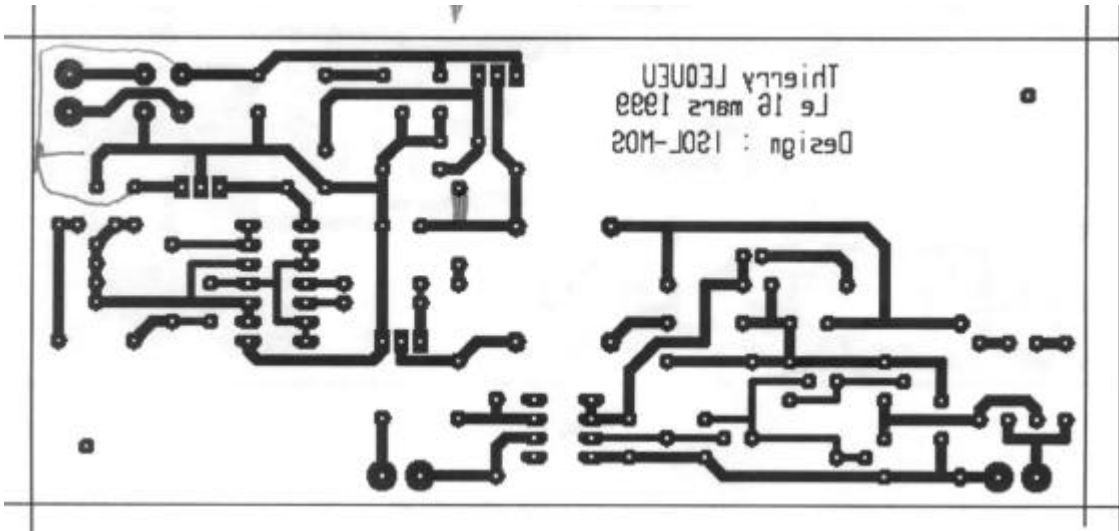


Fig. 8.7. Circuit imprimé coté cuivre (images-maquettes\isol_mos11.jpg).

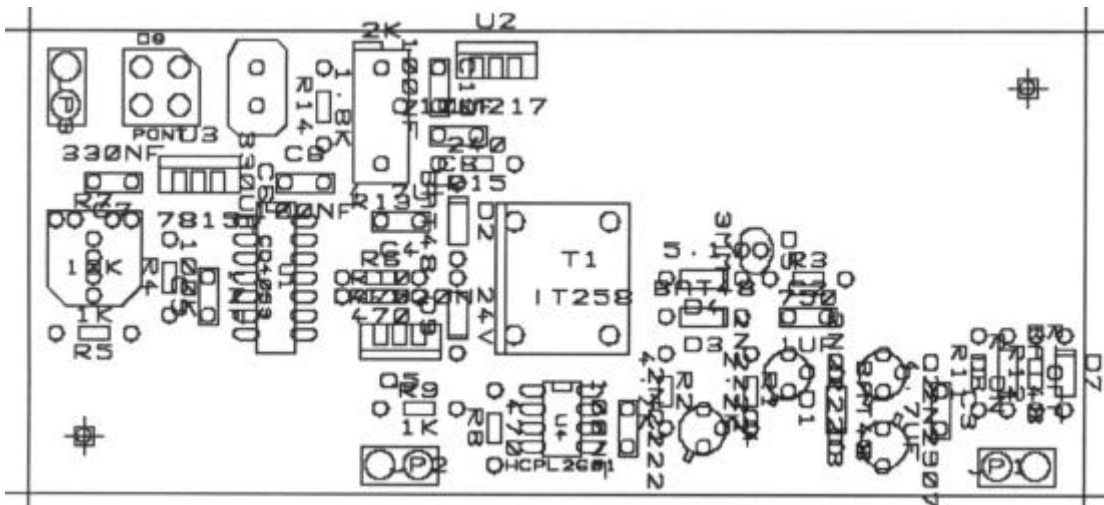


Fig. 8.8. Circuit imprimé coté composants (images-maquettes\isol_mos21.jpg).

8.6 Rélevés des formes d'ondes – Réglages

8.6.1 Fréquence de découpage

Il faut régler la résistance ajustable afin d'avoir une fréquence de découpage de 33 kHz, $T = 30 \mu\text{s}$ (figure 8.9), pour $C = 1 \text{ nF}$ et $R_{\text{ajustable}}$ variant de 10 k à 32 k Ω (10 k Ω fixe + 22 k Ω ajustable)

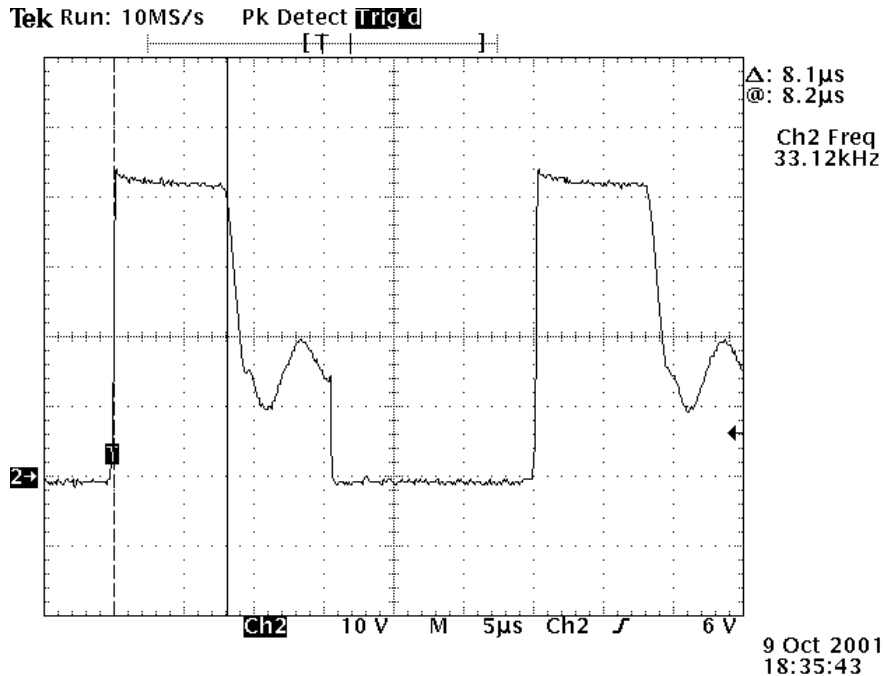


Fig. 8.9. Tension Drain–Source de l'IRF520 (images- maquettes\isol-mos00.pcx).

La durée de démagnétisation dure ici environ 8 μs et correspond à la décharge de l'inductance magnétisante dans la diode zener de 24 V.

La tension maximale aux bornes du transistor MOSFET de 42 V (figure 8.10) est égale à la somme de la tension d'alimentation du transformateur d'impulsions V_{ADJ} et de la tension de la diode zener 24V

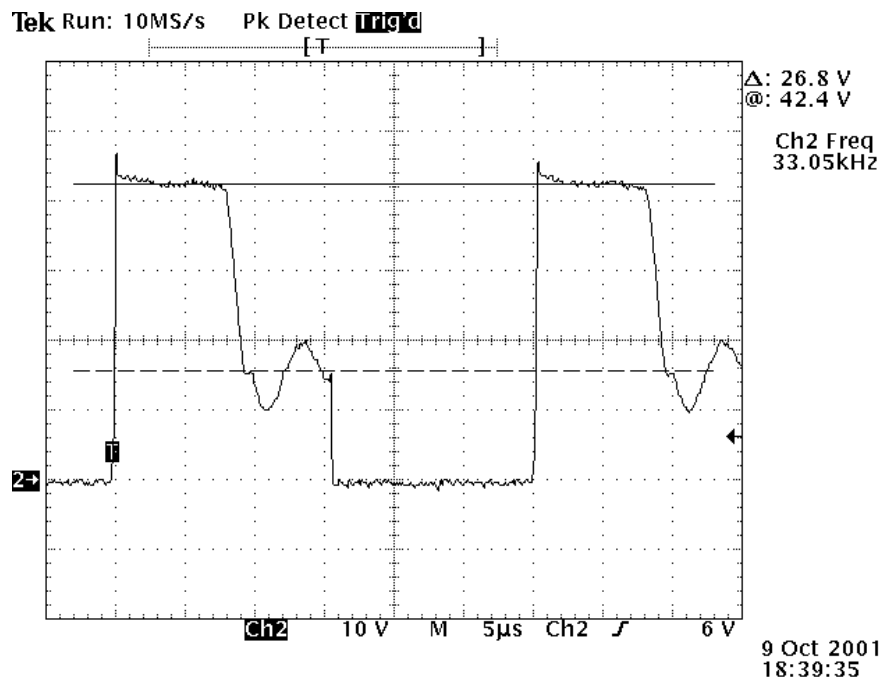


Fig. 8.10. Mesure de la tension maximale V_{DS} (images- maquettes\isol-mos01.pcx).

8.6.2 Régulateur de tension

Le régulateur LMx17 est ajusté afin d'avoir 15V de tension d'alimentation de l'étage de puissance de sortie. Le rapport de transformation de l'IT258 étant de 1, et en comptant 0,6V de chute de tension dans la diode de sortie, la tension de sortie du régulateur vaut 15,6V (15,66V mesuré pour 15,05V en sortie).

Il faut compter une consommation d'environ 80 mA à vide.

8.6.3 Exploitation

La figure 8.11 montre une commande de grille d'un transistor MOSFET IRF520 drain en l'air, à partir d'un signal de commande issue d'un GBF.

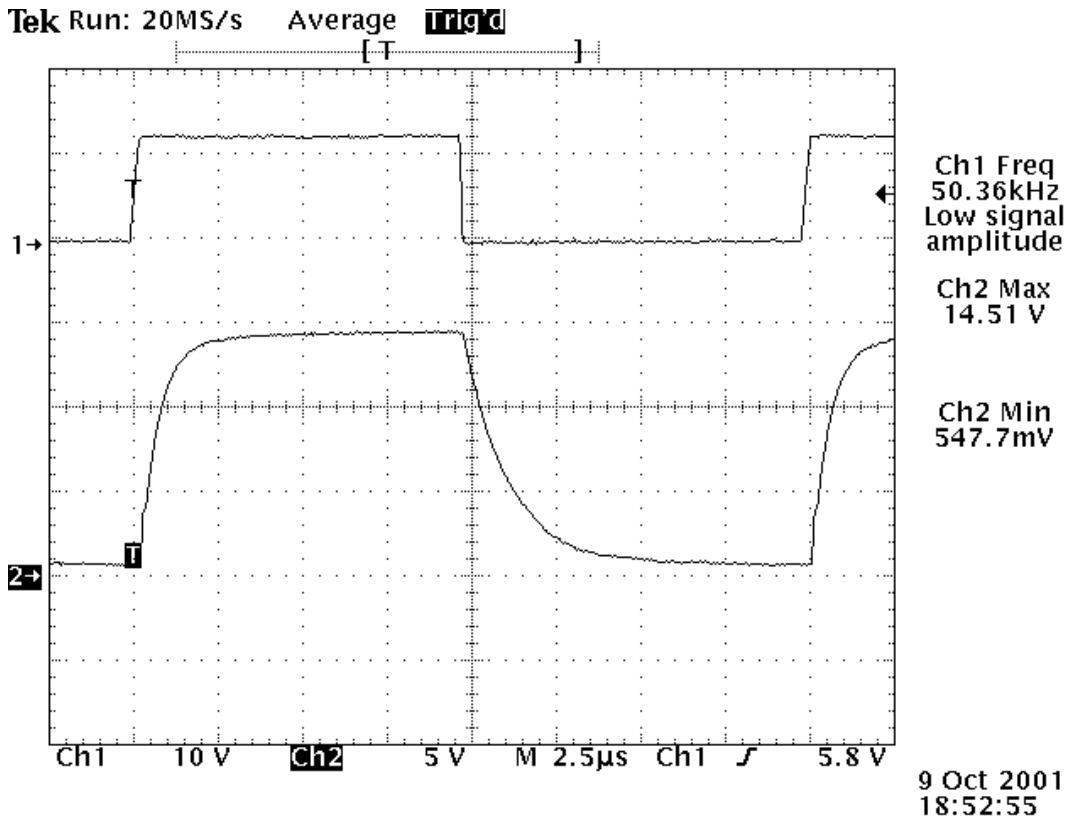


Fig. 8.11. Commande d'un transistor MOSFET IRF520 (images- maquettes\isol-mos02.pcx).

La résistance de charge vaut $R_{ON} = 470 \Omega$ et la résistance de décharge vaut $R_{OFF} = 1,2 \text{ k}\Omega$. La capacité d'entrée du transistor IRF 520 vaut $C_{ISS} = 500 \text{ pF}$ (environ). Le temps de charge vaut alors $T_{ON} = 3 \times \tau = 705 \text{ ns}$ et le temps de décharge vaut $T_{OFF} = 3 \times \tau = 1,8 \mu\text{s}$.

8.7 Test en dV/dt de la commande isolée

Date : le jeudi 18 mars 1999.

Mesure de I : shunt 0,1V/A + 5 tours.

Mesure de V : sonde par 10.

8.7.1 Capacité entre la masse du redresseur et le GND du transistor

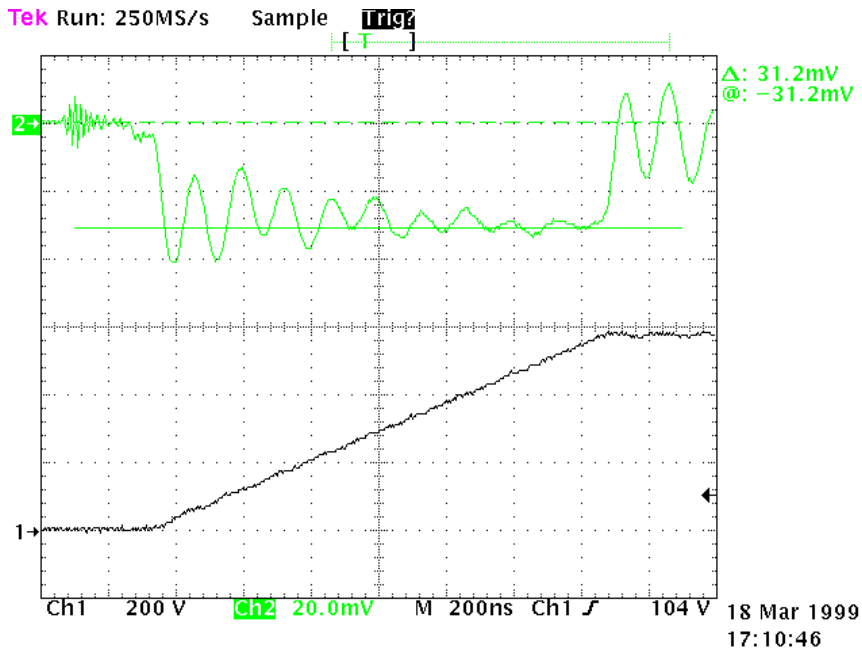


Fig. 8.12. Capacité du transformateur d'impulsion (1a) (images- maquettes\isol-mos04.bmp).

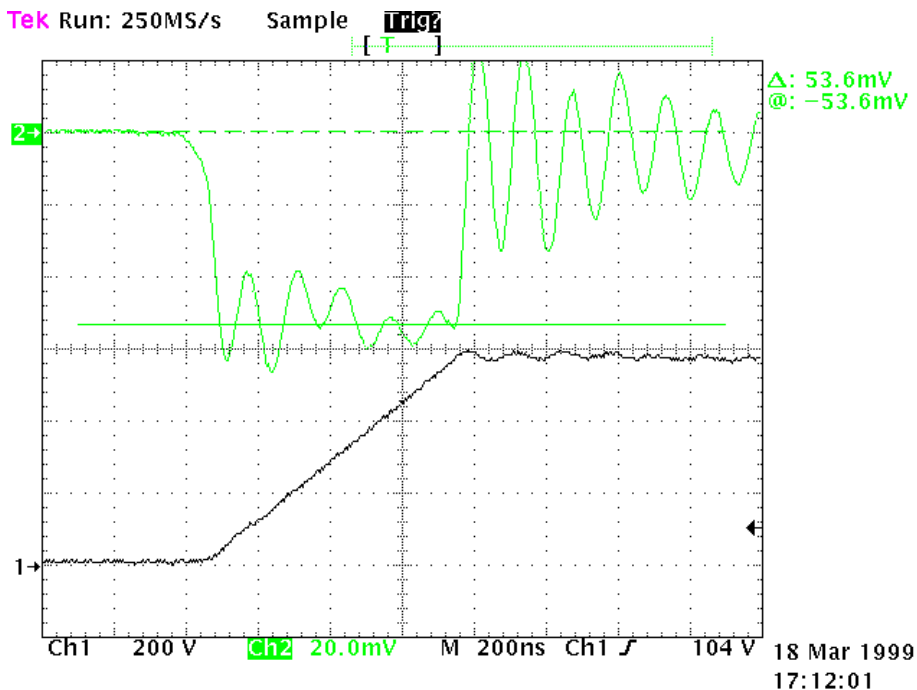


Fig. 8.13. Capacité du transformateur d'impulsion seule (1b) (images- maquettes\isol-mos05.bmp).

8.7.2 Capacité entre le GND du transistor et le GND de l'opto-coupleur

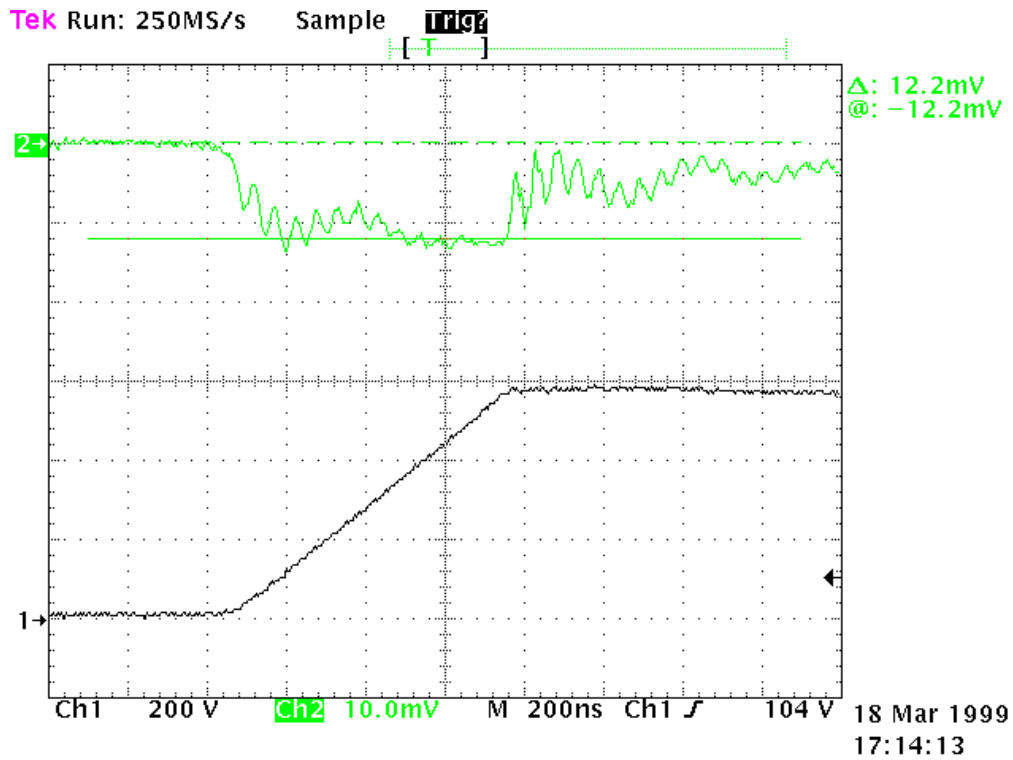


Fig. 8.14. Capacité de l'opto-coupleur (2a) (images- maquettes\isol-mos06.bmp).

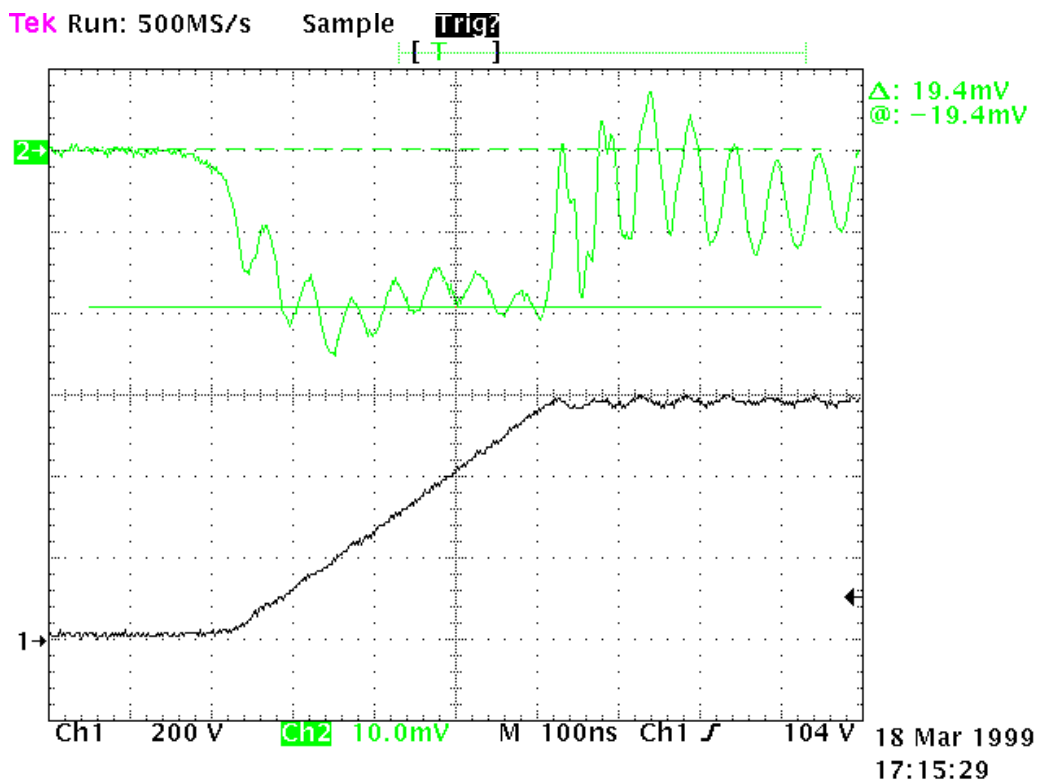


Fig. 8.15. Capacité de l'opto-coupleur (2b) (images- maquettes\isol-mos07.bmp).

8.7.3 Capacité entre la masse du redresseur et le GND de l'opto-coupleur

Idem précédemment.

8.7.4 Capacité du transformateur d'impulsion en série avec celle de l'opto-coupleur.

8.7.5 Capacité entre le GND du transistor et le GND de l'opto-coupleur - carte décaillée

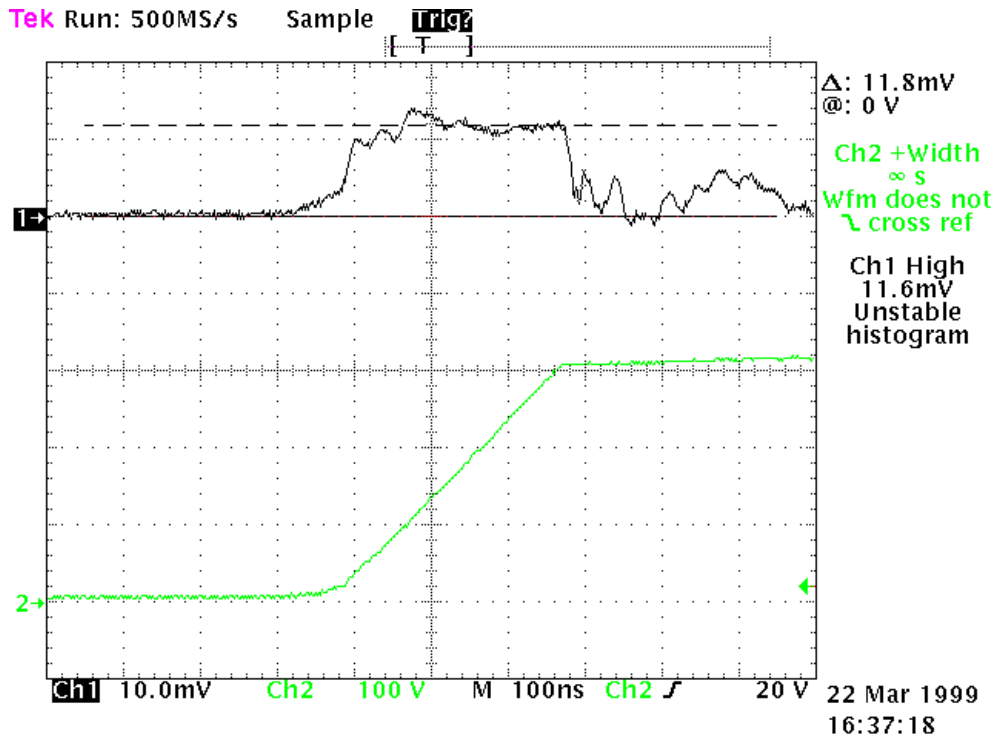


Fig. 8.16. Capacité de l'opto-coupleur - carte décaillée (3) (images- maquettes\isol-mos08.bmp).

8.7.6 Calcul des capacités

Tableau 8.3. Calculs des capacités (isol-mos.xls / CAPACITES).

		Cas 1	Cas 1	Cas 2	Cas 2	Cas 3	Cas 4
Courant	dV en mV	30,0	53,6	10,0	19,4	33,0	11,8
	Shunt (V/A)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
	Nb de spires	5	5	5	5	5	5
	I en mA	60	107	20	39	66	24
Tension	dV en V	580	580	580	580	580	300
Temps	dt en ns	1280	720	720	360	250	300
Capacité	C en pF	132	133	25	24	28	24

Cas 1 : Ck la capacité du transformateur d'impulsion est donnée à 80 pF pour un IT 258.

Cas 2 : la capacité de l'optocoupleur est donnée à 0.6 pF à 1 Mhz.

8.8 Essais en charge

Date : le jeudi 18 mars 1999.

Montage : Alimentation à découpage isolée de type "FORWARD" version 2

Tableau 8.4. Chute de tension dans le pont redresseur (isol-mos.xls /VERSION 2).

Ve DC en V	19,6	21,5	25,5	31,5
Ie DC en mA	125	125	126	127
Vc DC en V	18	20	24	30
Chute par diode (pont de diode)	0,8	0,75	0,75	0,75

Tableau 8.5. Chute de la tension de sortie (isol-mos.xls /VERSION 2).

Vout en V	15,01	14,87	14,83	14,78	14,54	14,28	14
Iout en mA	0	15	20	25	50	75	100
Calibre Iout	0,02	0,02	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Iin en mA	121	135	140	145	160	193	216
Calibre Iin	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Test sous 25V DC constant en entrée - IT258

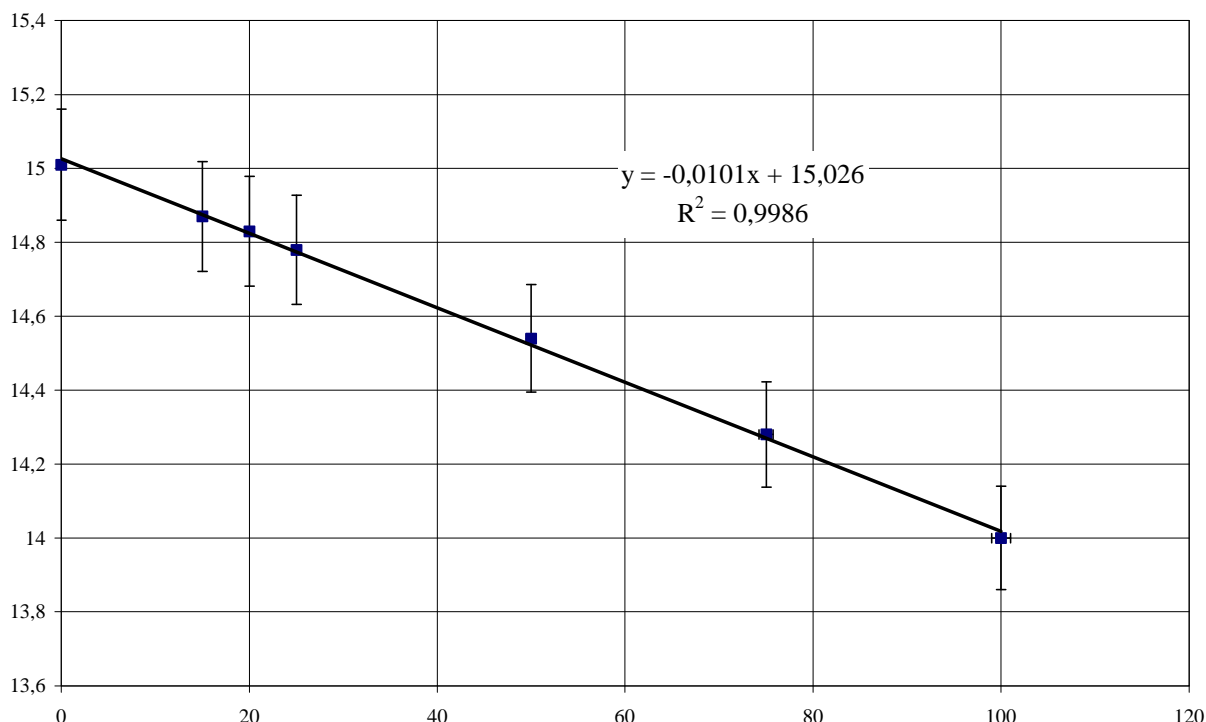


Fig. 8.17. Tension de sortie en fonction du courant de sortie (isol-mos.xls /VERSION 2).

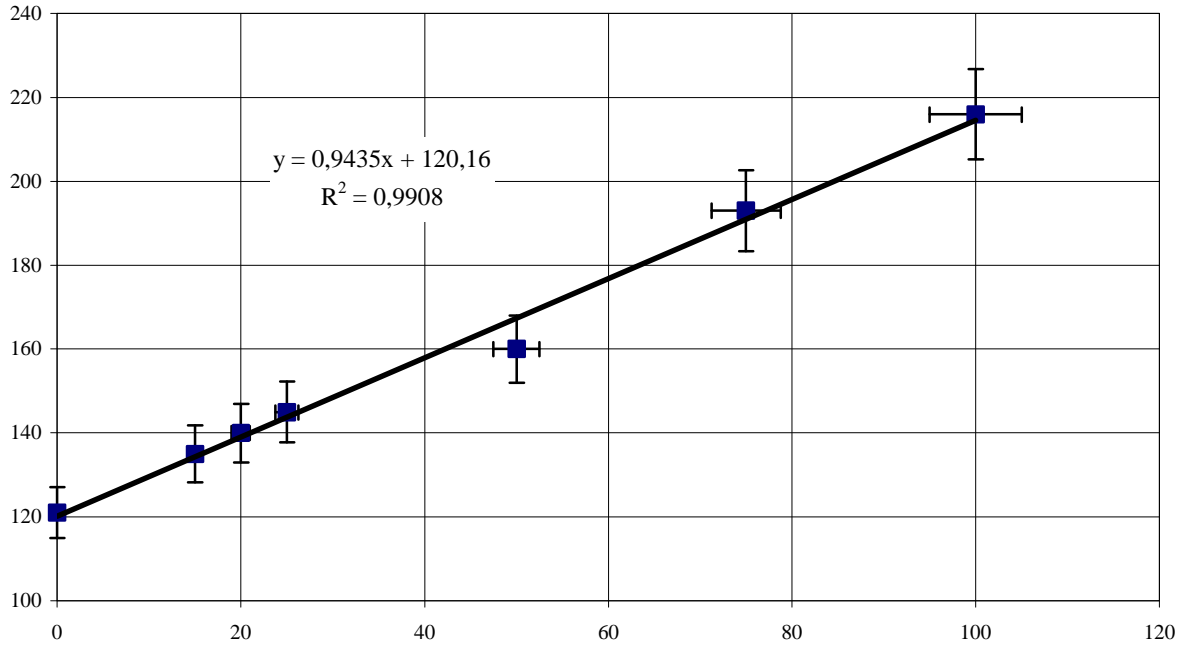
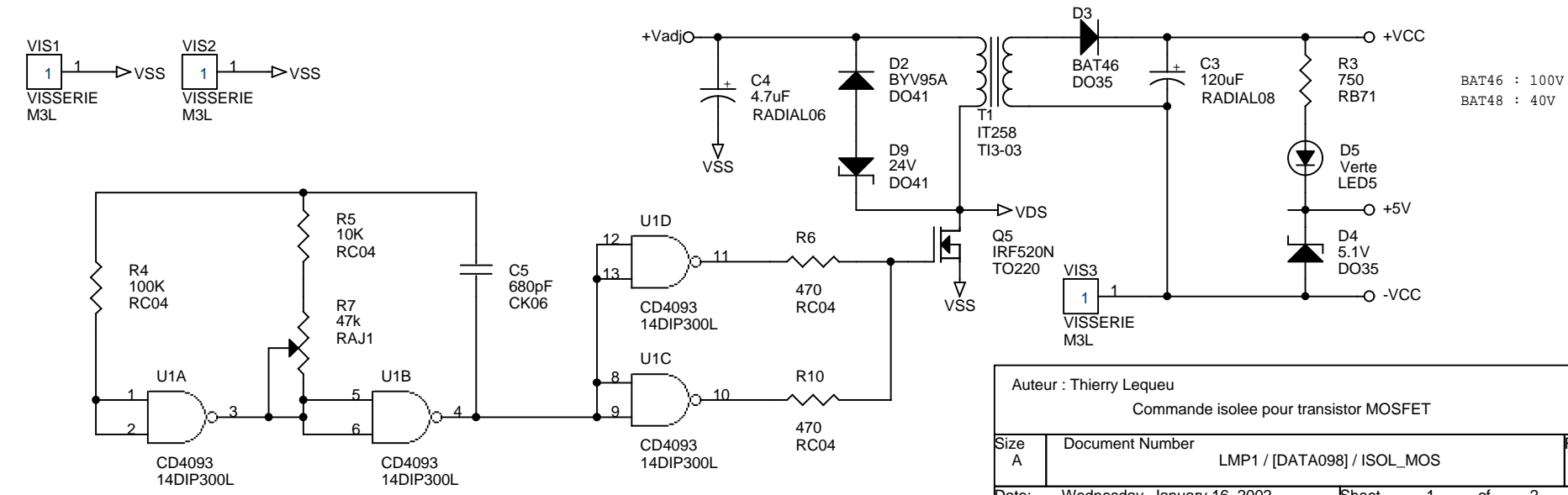
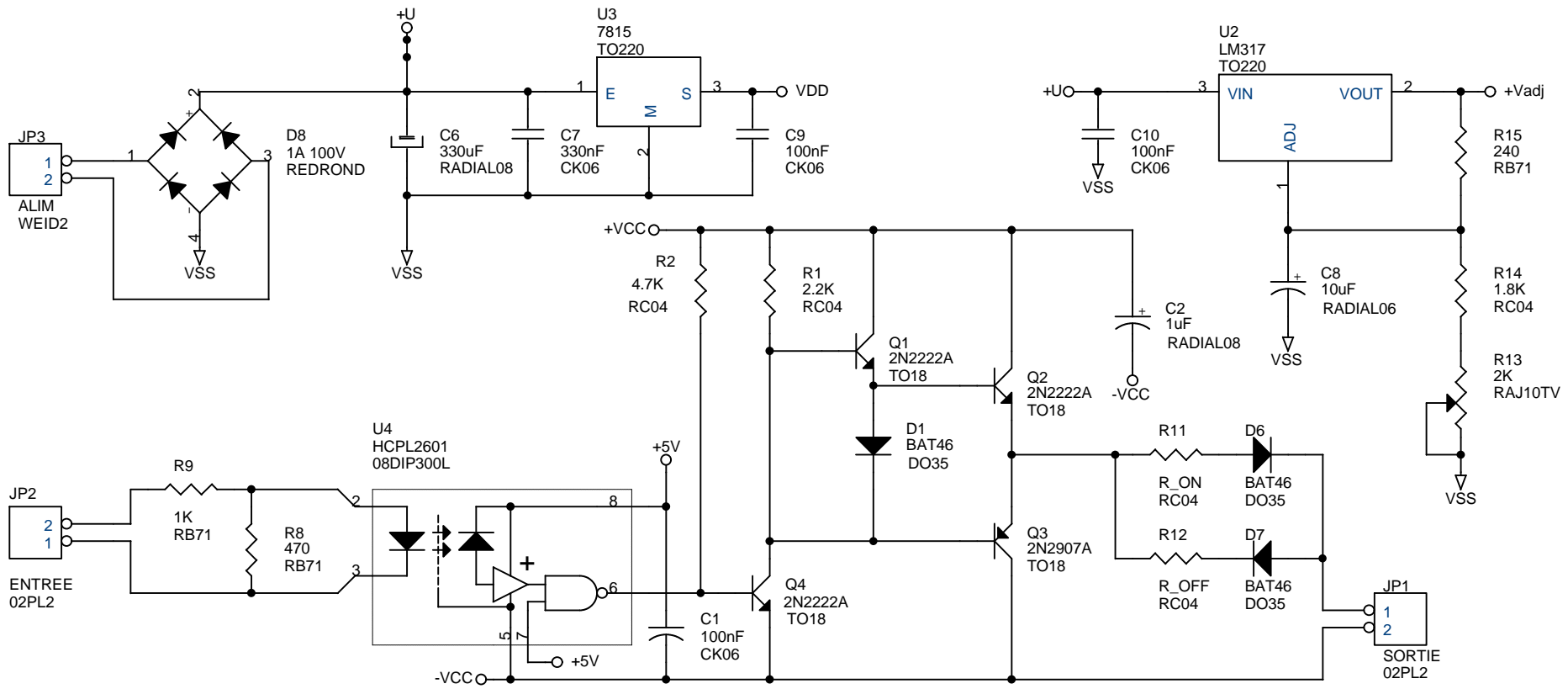


Fig. 8.18. Courant d'entrée en fonction du courant de sortie (isol-mos.xls /VERSION 2).

Commande isolée pour transistor MOSFET
LMP1 / [DATA098] / ISOL_MOS Revision: 5
Revised: Wednesday, January 16, 2002

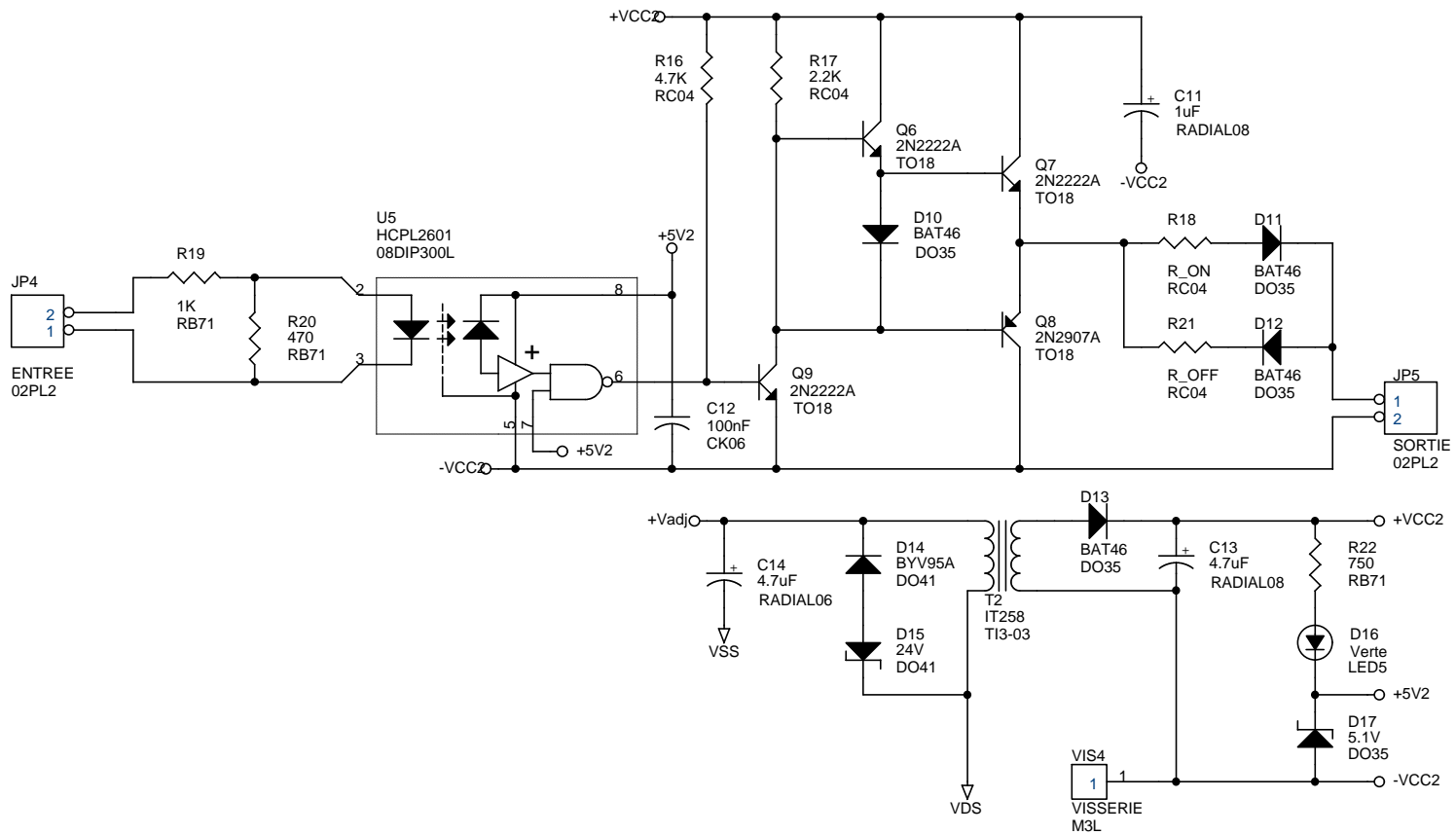
Réf.	Qu.	Désignation	Fournisseur	Date	Code Cde	U.d.V.	Prix U.H.T.	Prix T.H.T.	
C1,C9,C10,C12	4	100 nF100V Polyester	Radiospares	16-janv-02	166-8433	10	, €	, €	4,38 F
C11,C2	2	uF V série M	Radiospares	16-janv-02	228-6846	5	, €	, €	0,89 F
C3	1	uF V série FC (faible impédance)	Radiospares	16-janv-02	315-0855	5	, €	, €	2,55 F
C13,C14,C4	2	uF V série FC (faible impédance)	Radiospares	16-janv-02	315-0805	5	, €	, €	2,41 F
C5	1	680pF 100V RPE	Radiospares	16-janv-02	188-6136	25	, €	, €	1,21 F
C6	1	uF V série M	Radiospares	16-janv-02	228-6795	5	, €	, €	2,11 F
C7	1	330nF 250V MKT	Radiospares	16-janv-02	166-8534	10	, €	, €	1,85 F
C8	1	uF V série FC (faible impédance)	Radiospares	16-janv-02	315-0805	5	, €	, €	1,21 F
D1,D3,D6,D7,D10,D11,D12,D13	7	BAT46	Radiospares	16-janv-02	251-3069	10	, €	, €	12,67 F
D14,D2	2	BYV95A	Radiospares	16-janv-02	196-1007	5	, €	, €	4,20 F
D17,D4	2	zener 5.1V	Radiospares	16-janv-02	283-659	5	, €	, €	1,36 F
D16,D5	2	LED 3mm verte	Radiospares	16-janv-02	178-8502	10	, €	, €	6,06 F
D8	1	Pont redresseur 1A 100V	Farnell	1-juin-00	572-755	1	, €	, €	1,77 F
D15,D9	2	zener 24V	Radiospares	16-janv-02	112-7825	3	, €	, €	2,27 F
JP5,JP1	2	Connecteur, pas 5mm, 2 points, Camdem	Radiospares	16-janv-02	131-8920	10	, €	, €	2,74 F
JP4,JP2	2	Connecteur, pas 5mm, 2 points, Camdem	Radiospares	16-janv-02	131-8920	10	, €	, €	2,74 F
JP3	2	Embases coudées ouvertes points Weidmuller	Radiospares	16-janv-02	403-998	5	, €	, €	3,38 F
Q1,Q2,Q4,Q6,Q7,Q9	6	2N2222A	Radiospares	16-janv-02	295-028	1	, €	, €	33,85 F
Q8,Q3	2	2N2907A	Radiospares	16-janv-02	349-9043	5	, €	, €	16,69 F
Q5	1	IRF520N	Radiospares	16-janv-02	254-0853	1	, €	, €	8,86 F
R17,R1	2	2.2K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R16,R2	2	4.7K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R22,R3	2	750	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R4	1	100K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,13 F
R5	1	10K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,13 F
R6,R10	2	470	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R7	1	47k ajustable PT10	Radiospares	16-janv-02	187-040	1	, €	, €	8,92 F
R20,R8	2	470	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R19,R9	2	1K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R18,R11	2	R_ON	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R21,R12	2	R_OFF	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,26 F
R13	1	2K ajustable multitour	Radiospares	16-janv-02	375-916	1	, €	, €	15,35 F
R14	1	1.8K	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,13 F
R15	1	240	LMP	16-janv-02	R	1	, €	, €	0,13 F
T2,T1	2	IT258	Radiospares	16-janv-02	173-6423	1	, €	, €	112,04 F
U1	2	CD4093	Radiospares	16-janv-02	345-5728	1	, €	, €	4,46 F
U2	1	LM317	Radiospares	16-janv-02	641-702	1	, €	, €	6,36 F
U3	1	7815	Radiospares	16-janv-02	648-444	1	, €	, €	4,07 F
U5,U4	1	HCPL2601	Radiospares	16-janv-02	303-129	1	, €	, €	38,37 F
Divers		Dissipateur KL205	Radiospares	16-janv-02	218-2205	1	, €	, €	0,00 F
Divers	1	Ecrou inox A2 M3	Radiospares	16-janv-02	527-230	250	, €	, €	1,53 F
Divers	1	Rondelles anti-desserrage	Radiospares	16-janv-02	180-0557	100	, €	, €	0,13 F
Divers	1	Vis inox M3x12	Radiospares	16-janv-02	526-962	100	, €	, €	0,36 F
Divers	4	M3x6	Radiospares	16-janv-02	526-940	100	, €	, €	1,33 F
Divers	4	Rondelle inox éventail M	Radiospares	16-janv-02	180-0557	100	, €	, €	0,51 F
Divers	4	Entretoise mâle/femelle mm	Radiospares	16-janv-02	125-6002	50	, €	, €	7,58 F
Divers	2	Support tulipe 8 broches	Radiospares	16-janv-02	100-9935	10	, €	, €	5,51 F
Divers	1	Support tulipe 14 broches	Radiospares	16-janv-02	100-9941	10	, €	, €	4,97 F
Divers	115	Circuit imprimé D.F. , x , cm	Radiospares	19-janv-02	159-6120	600	, €	, €	24,60 F

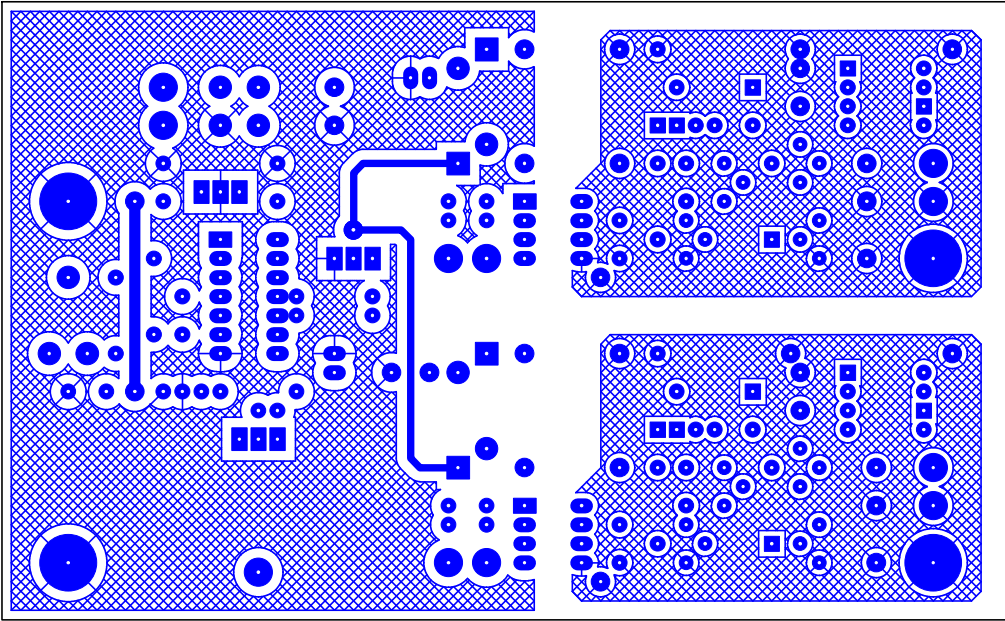
TOTAL H.T. :	, €	351,93 F
dont TVA :	19,60%	, € 68,98 F
TOTAL T.T.C. :	, €	420,90 F

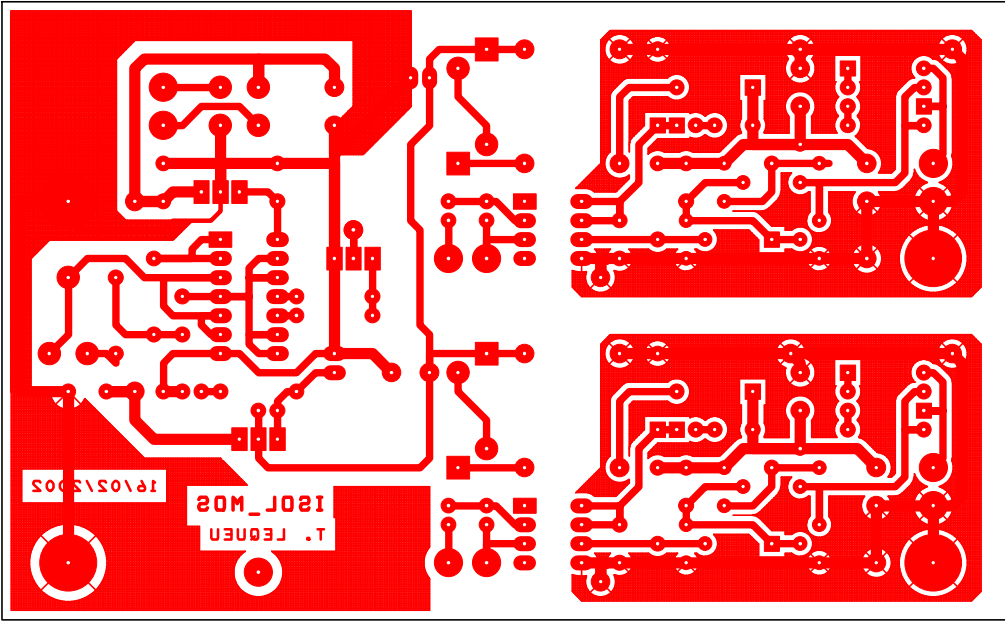


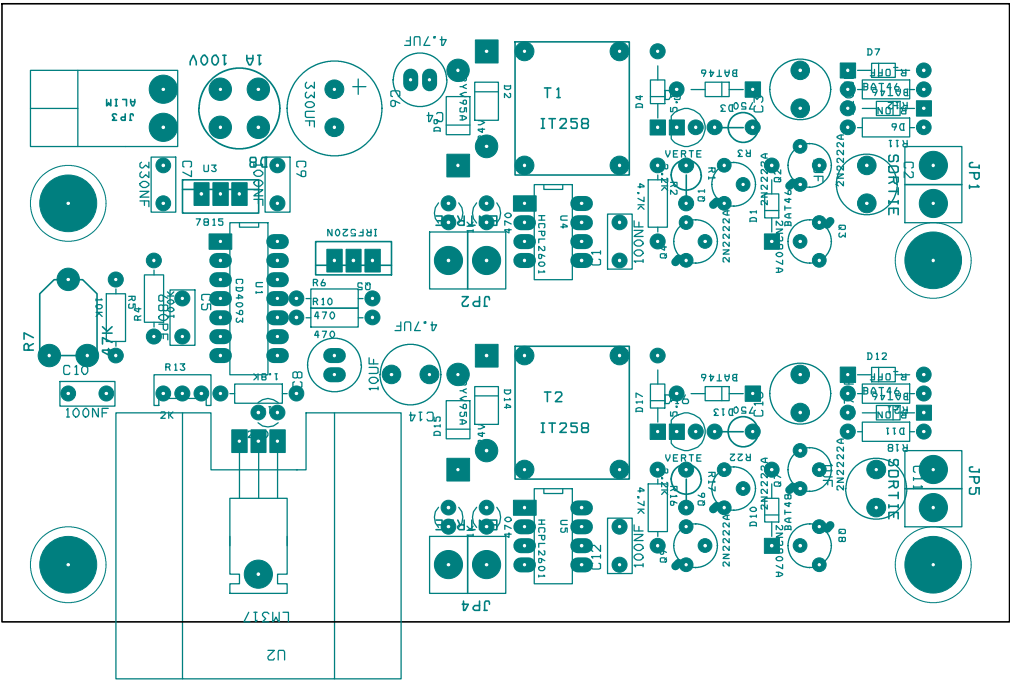
BAT46 : 100V
BAT48 : 40V

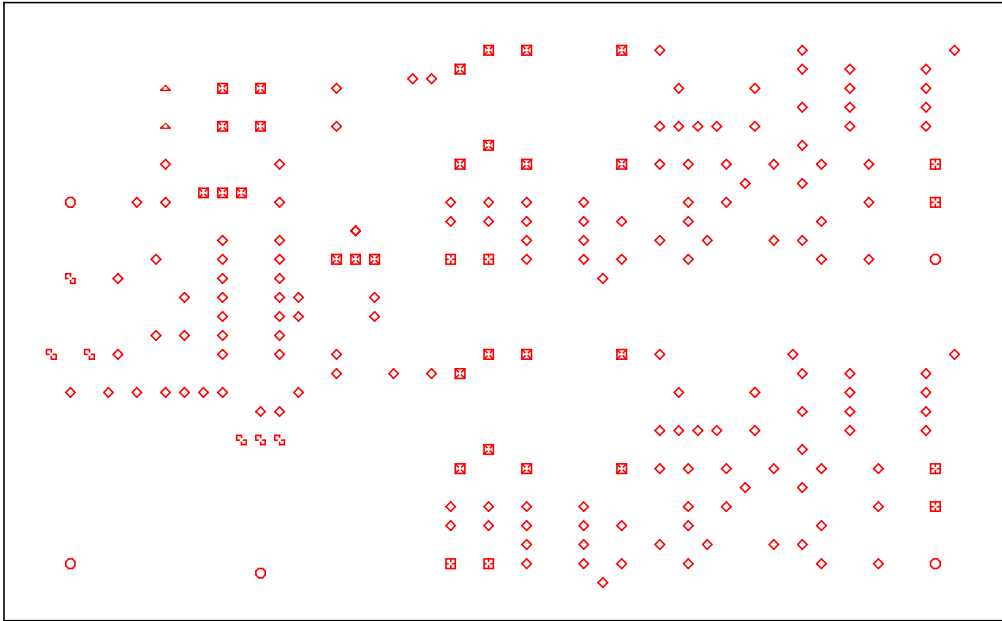
Auteur : Thierry Lequeu		
Commande isolee pour transistor MOSFET		
Size A	Document Number LMP1 / [DATA098] / ISOL_MOS	Rev 5
Date: Wednesday, January 16, 2002	Sheet 1	of 2











DRILL CHART				
SYM	DIAM	TOL	QTY	NOTE
◇	0.787 mm		160	
⊠	0.991 mm		26	
⊞	1.000 mm		8	
⊕	1.194 mm		6	
△	1.499 mm		2	
○	3.200 mm		5	
TOTAL			207	

High CMR, High Speed TTL Compatible Optocouplers

Technical Data

6N137	
HCNW137	HCPL-0631
HCNW2601	HCPL-0661
HCNW2611	HCPL-2601
HCPL-0600	HCPL-2611
HCPL-0601	HCPL-2630
HCPL-0611	HCPL-2631
HCPL-0630	HCPL-4661

Features

- **5 kV/μs Minimum Common Mode Rejection (CMR) at $V_{CM} = 50$ V for HCPL-X601/X631, HCNW2601 and 10 kV/μs Minimum CMR at $V_{CM} = 1000$ V for HCPL-X611/X661, HCNW2611**
- **High Speed: 10 MBd Typical**
- **LSTTL/TTL Compatible**
- **Low Input Current Capability: 5 mA**
- **Guaranteed ac and dc Performance over Temperature: -40°C to +85°C**
- **Available in 8-Pin DIP, SOIC-8, Widebody Packages**
- **Stroable Output (Single Channel Products Only)**
- **Safety Approval**
UL Recognized - 2500 V rms for 1 minute and 5000 V rms* for 1 minute per UL1577
CSA Approved
VDE 0884 Approved with $V_{IORM} = 630$ V peak for HCPL-2611 Option 060 and $V_{IORM} = 1414$ V peak for HCNW137/26X1
BSI Certified (HCNW137/26X1 Only)
- **MIL-STD-1772 Version Available (HCPL-56XX/66XX)**

Applications

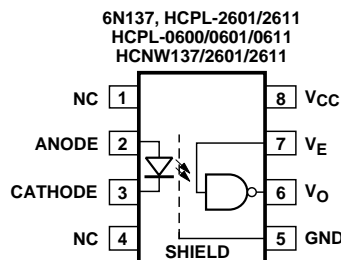
- **Isolated Line Receiver**
- **Computer-Peripheral Interfaces**
- **Microprocessor System Interfaces**
- **Digital Isolation for A/D, D/A Conversion**
- **Switching Power Supply**
- **Instrument Input/Output Isolation**
- **Ground Loop Elimination**
- **Pulse Transformer Replacement**

- **Power Transistor Isolation in Motor Drives**
- **Isolation of High Speed Logic Systems**

Description

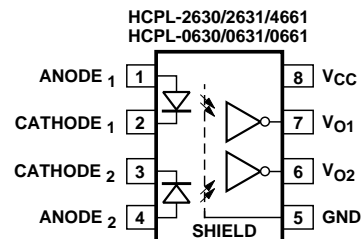
The 6N137, HCPL-26XX/06XX/4661, HCNW137/26X1 are optically coupled gates that combine a GaAsP light emitting diode and an integrated high gain photo detector. An enable input allows the detector to be strobed. The output of the detector IC is

Functional Diagram



TRUTH TABLE (POSITIVE LOGIC)

LED	ENABLE	OUTPUT
ON	H	L
OFF	H	H
ON	L	H
OFF	L	H
ON	NC	L
OFF	NC	H



TRUTH TABLE (POSITIVE LOGIC)

LED	OUTPUT
ON	L
OFF	H

*5000 V rms/1 Minute rating is for HCNW137/26X1 and Option 020 (6N137, HCPL-2601/11/30/31, HCPL-4661) products only.

A 0.1 μF bypass capacitor must be connected between pins 5 and 8.

CAUTION: It is advised that normal static precautions be taken in handling and assembly of this component to prevent damage and/or degradation which may be induced by ESD.

9.2A, 100V, 0.270 Ohm, N-Channel Power MOSFET

This N-Channel enhancement mode silicon gate power field effect transistor is an advanced power MOSFET designed, tested, and guaranteed to withstand a specified level of energy in the breakdown avalanche mode of operation. All of these power MOSFETs are designed for applications such as switching regulators, switching convertors, motor drivers, relay drivers, and drivers for high power bipolar switching transistors requiring high speed and low gate drive power. These types can be operated directly from integrated circuits.

Formerly developmental type TA09594.

Ordering Information

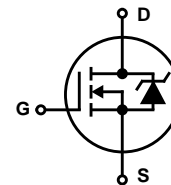
PART NUMBER	PACKAGE	BRAND
IRF520	TO-220AB	IRF520

NOTE: When ordering, use the entire part number.

Features

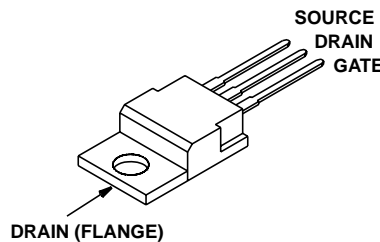
- 9.2A, 100V
- $r_{DS(ON)} = 0.270\Omega$
- SOA is Power Dissipation Limited
- Single Pulse Avalanche Energy Rated
- Nanosecond Switching Speeds
- Linear Transfer Characteristics
- High Input Impedance
- Related Literature
 - TB334 "Guidelines for Soldering Surface Mount Components to PC Boards"

Symbol



Packaging

JEDEC TO-220AB



1.2V TO 37V VOLTAGE REGULATOR

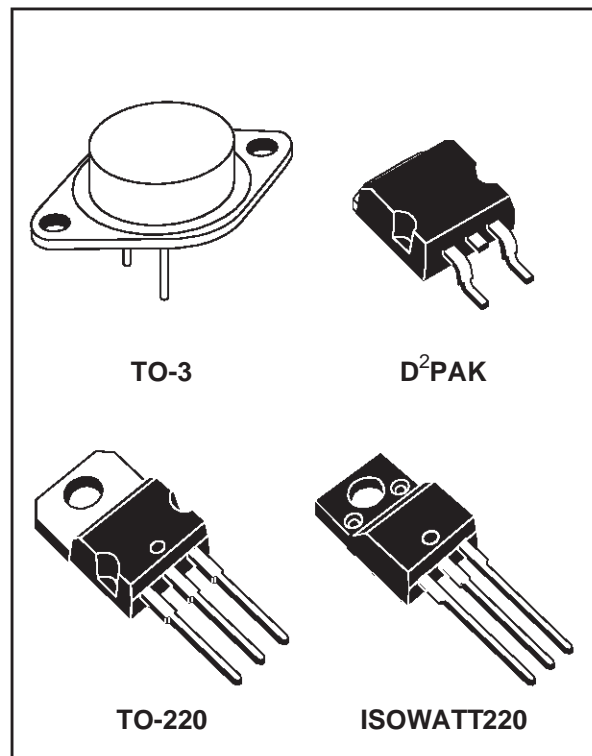
- OUTPUT VOLTAGE RANGE : 1.2 TO 37V
- OUTPUT CURRENT IN EXCESS OF 1.5A
- 0.1% LINE AND LOAD REGULATION
- FLOATING OPERATION FOR HIGH VOLTAGES
- COMPLETE SERIES OF PROTECTIONS : CURRENT LIMITING, THERMAL SHUTDOWN AND SOA CONTROL

DESCRIPTION

The LM117/LM217/LM317 are monolithic integrated circuit in TO-220, ISOWATT220, TO-3 and D²PAK packages intended for use as positive adjustable voltage regulators.

They are designed to supply more than 1.5A of load current with an output voltage adjustable over a 1.2 to 37V range.

The nominal output voltage is selected by means of only a resistive divider, making the device exceptionally easy to use and eliminating the stocking of many fixed regulators.



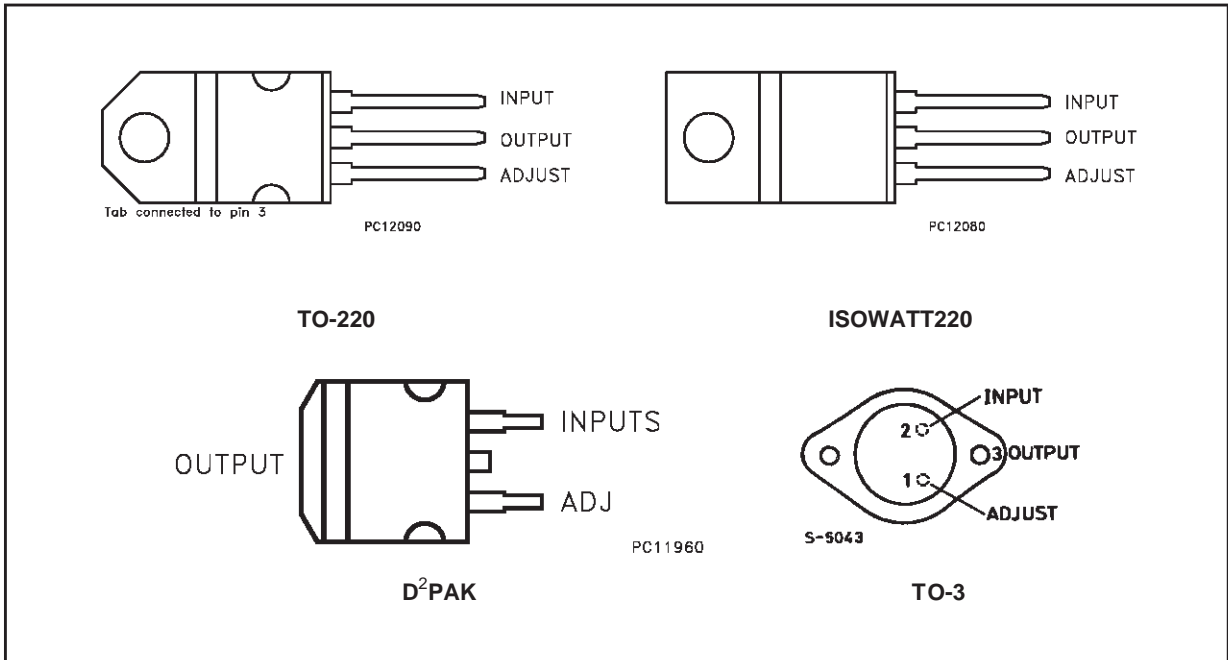
ABSOLUTE MAXIMUM RATING

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{i-o}	Input-output Differential Voltage	40	V
I_o	Output Current	Internally Limited	
T_{op}	Operating Junction Temperature for: LM117 LM217 LM317	-55 to 150 -25 to 150 0 to 125	°C °C °C
P_{tot}	Power Dissipation	Internally Limited	
T_{stg}	Storage Temperature	- 65 to 150	°C

THERMAL DATA

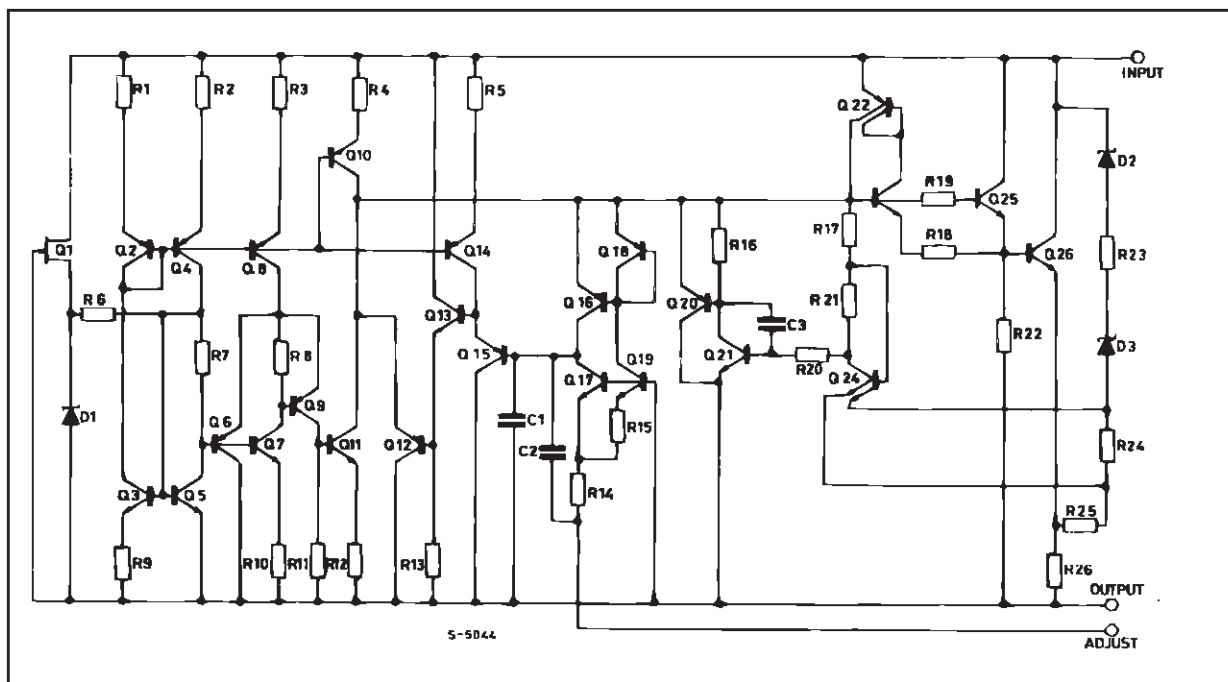
Symbol	Parameter	TO-3	TO-220	ISOWATT220	D ² PAK	Unit
$R_{thj-case}$	Thermal Resistance Junction-case	4	3	4	3	°C/W
$R_{thj-amb}$	Thermal Resistance Junction-ambient	35	50	60	62.5	°C/W

CONNECTION DIAGRAM AND ORDERING NUMBERS (top view)



Type	TO-3	TO-220	ISOWATT220	D ² PAK
LM117	LM117K			
LM217	LM217K	LM217T		LM217D2T
LM317	LM317K	LM317T	LM317P	LM317D2T

SCHEMATIC DIAGRAM

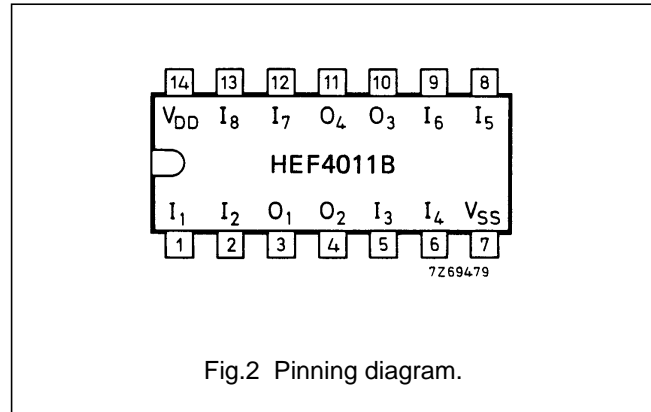
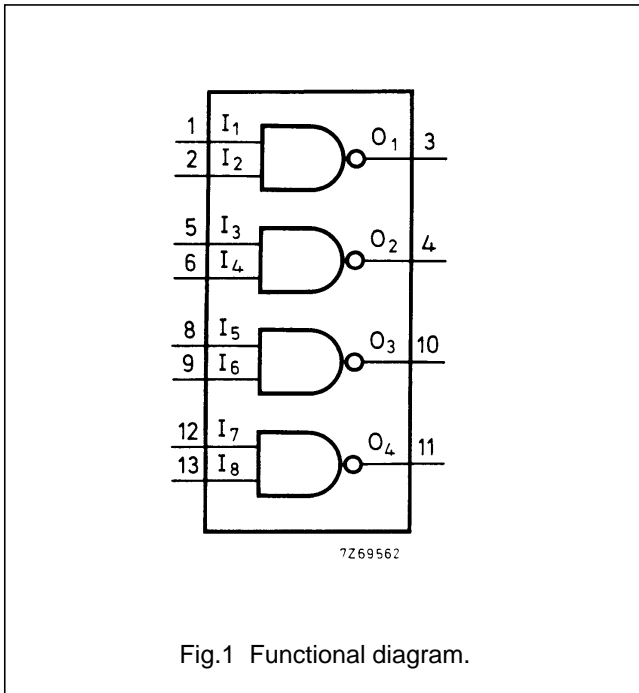


Quadruple 2-input NAND gate

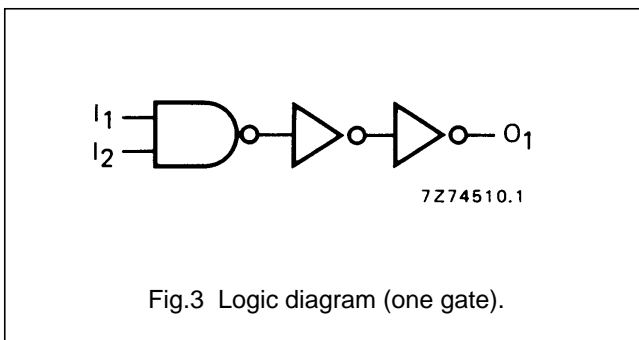
HEF4011B gates

DESCRIPTION

The HEF4011B provides the positive quadruple 2-input NAND function. The outputs are fully buffered for highest noise immunity and pattern insensitivity of output impedance.



- HEF4011BP(N): 14-lead DIL; plastic (SOT27-1)
 - HEF4011BD(F): 14-lead DIL; ceramic (cerdip) (SOT73)
 - HEF4011BT(D): 14-lead SO; plastic (SOT108-1)
- (): Package Designator North America



FAMILY DATA, I_{DD} LIMITS category GATES

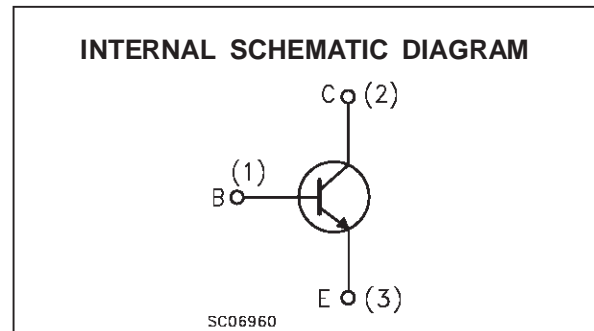
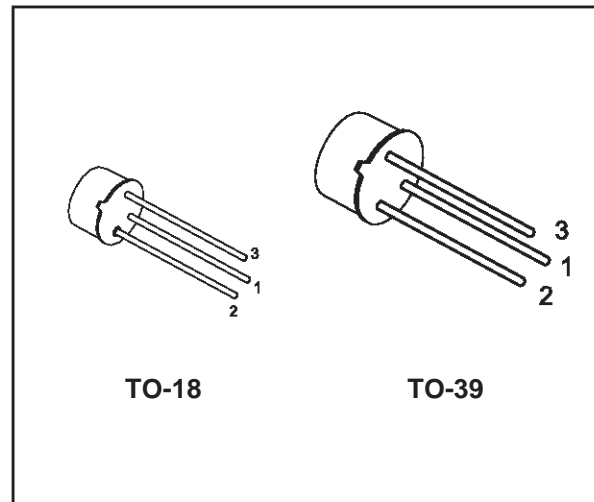
See Family Specifications

HIGH SPEED SWITCHES

DESCRIPTION

The 2N2219A and 2N2222A are silicon planar epitaxial NPN transistors in Jedec TO-39 (for 2N2219A) and in Jedec TO-18 (for 2N2222A) metal case. They are designed for high speed switching application at collector current up to 500mA, and feature useful current gain over a wide range of collector current, low leakage currents and low saturation voltage.

☞ 2N2219A approved to CECC 50002-100,
2N2222A approved to CECC 50002-101
available on request.



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

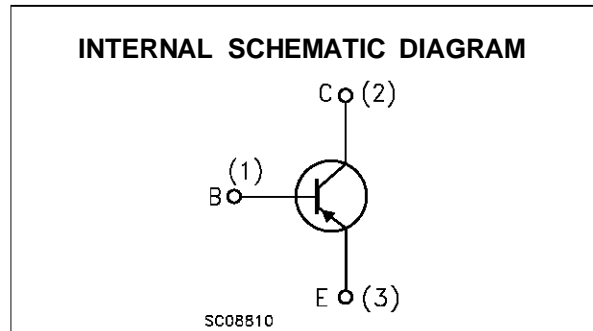
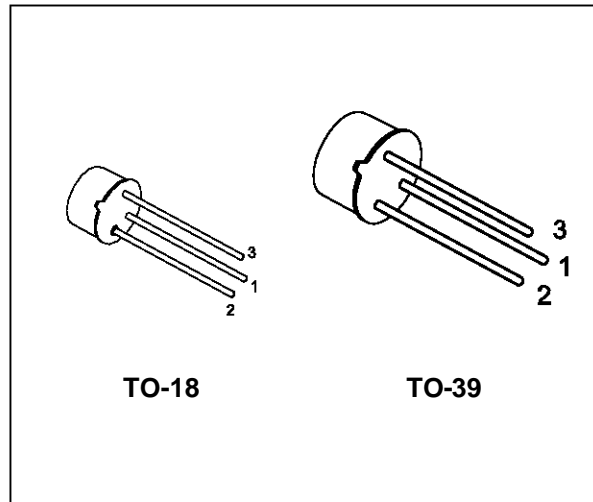
Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	75	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	40	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	6	V
I_C	Collector Current	0.8	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_{amb} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ for 2N2219A for 2N2222A at $T_{case} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ for 2N2219A for 2N2222A	0.8	W
		0.5	W
		3	W
		1.8	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. Operating Junction Temperature	175	$^\circ\text{C}$

GENERAL PURPOSE AMPLIFIERS AND SWITCHES

DESCRIPTION

The 2N2905A and 2N2907A are silicon planar epitaxial PNP transistors in Jedec TO-39 (for 2N2905A) and in Jedec TO-18 (for 2N2907A) metal case. They are designed for high speed saturated switching and general purpose applications.

- ☰ 2N2905A approved to CECC 50002-100, 2N2906A approved to CECC 50002-103 available on request.



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value	Unit
V_{CBO}	Collector-Base Voltage ($I_E = 0$)	-60	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage ($I_B = 0$)	-60	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage ($I_C = 0$)	-5	V
I_C	Collector Current	-0.6	A
P_{tot}	Total Dissipation at $T_{amb} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ for 2N2905A for 2N2907A at $T_{case} \leq 25\text{ }^\circ\text{C}$ for 2N2905A for 2N2907A	0.6	W
		0.4	W
		3	W
		1.8	W
T_{stg}	Storage Temperature	-65 to 200	$^\circ\text{C}$
T_j	Max. Operating Junction Temperature	200	$^\circ\text{C}$